

Silicon Power Schottky Diode

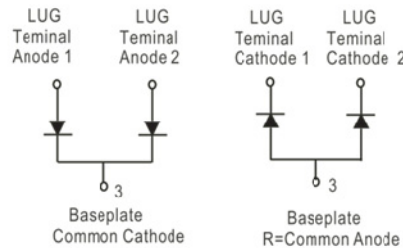
$V_{RRM} = 150\text{ V} - 200\text{ V}$

$I_{F(AV)} = 200\text{ A}$

Features

- High Surge Capability
- Types from 150 V to 200 V V_{RRM}
- Not ESD Sensitive

Twin Tower Package



Maximum ratings, at $T_j = 25\text{ °C}$, unless otherwise specified ("R" devices have leads reversed)

Parameter	Symbol	Conditions	MBR200150CT(R)	MBR200200CT(R)	Unit
Repetitive peak reverse voltage	V_{RRM}		150	200	V
RMS reverse voltage	V_{RMS}		106	141	V
DC blocking voltage	V_{DC}		150	200	V
Operating temperature	T_j		-55 to 150	-55 to 150	°C
Storage temperature	T_{stg}		-55 to 150	-55 to 150	°C

Electrical characteristics, at $T_j = 25\text{ °C}$, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Conditions	MBR200150CT(R)	MBR200200CT(R)	Unit
Average forward current (per pkg)	$I_{F(AV)}$	$T_C = 125\text{ °C}$	200	200	A
Peak forward surge current (per leg)	I_{FSM}	$t_p = 8.3\text{ ms}$, half sine	1500	1500	A
Maximum forward voltage (per leg)	V_F	$I_{FM} = 100\text{ A}$, $T_j = 25\text{ °C}$	0.88	0.92	V
Reverse current at rated DC blocking voltage (per leg)	I_R	$T_j = 25\text{ °C}$	3	3	mA
		$T_j = 100\text{ °C}$	10	10	
		$T_j = 150\text{ °C}$	50	50	

Thermal characteristics

Thermal resistance, junction-case (per leg)	$R_{\theta JC}$		0.45	0.45	°C/W
---	-----------------	--	------	------	------

Figure .1- Typical Forward Characteristics

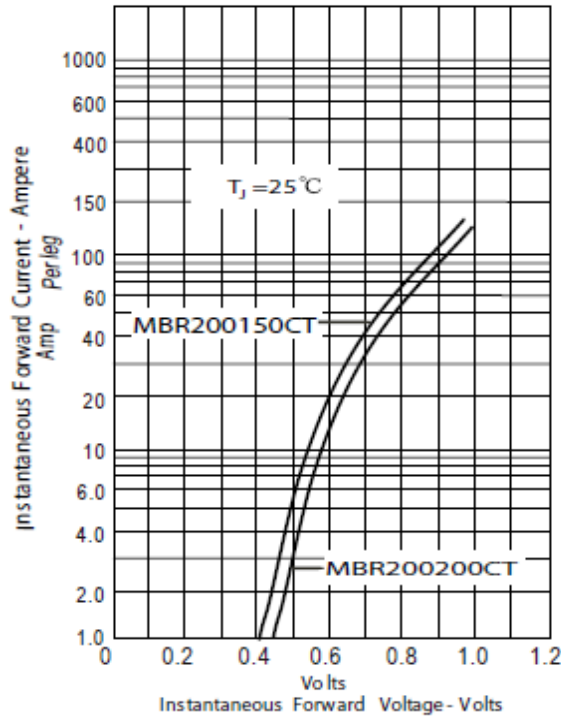


Figure .2- Forward Derating Curve

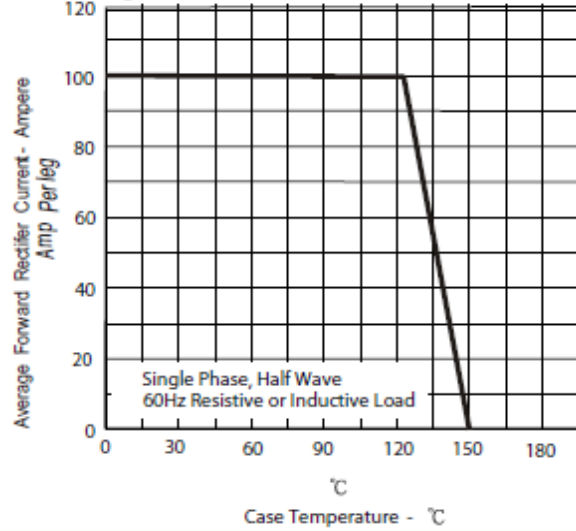


Figure .3- Peak Forward Surge Current

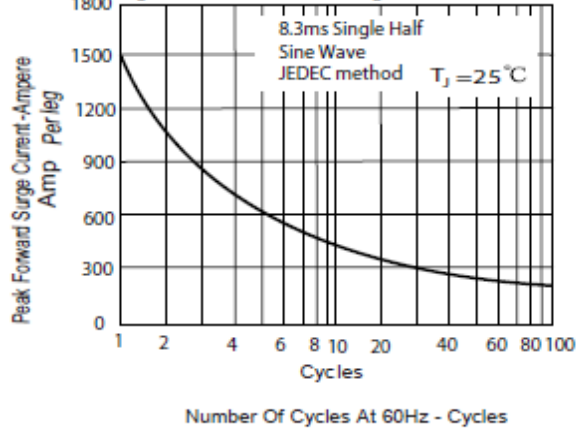
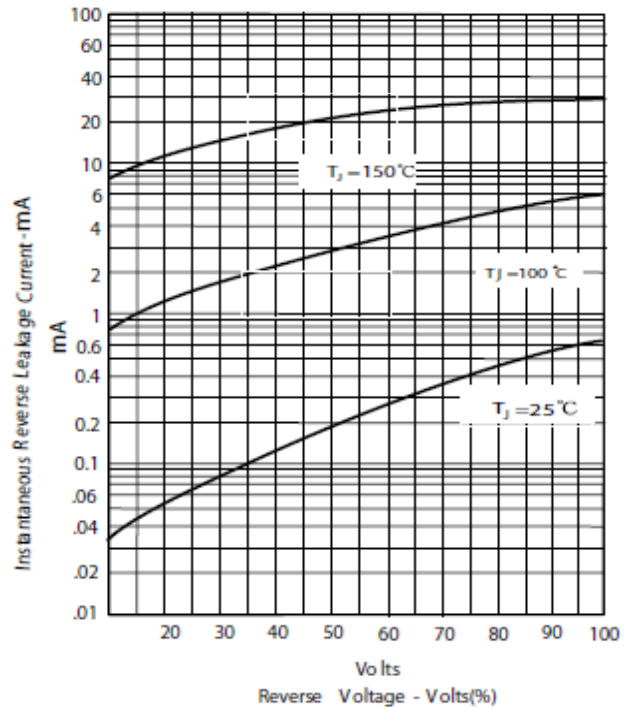
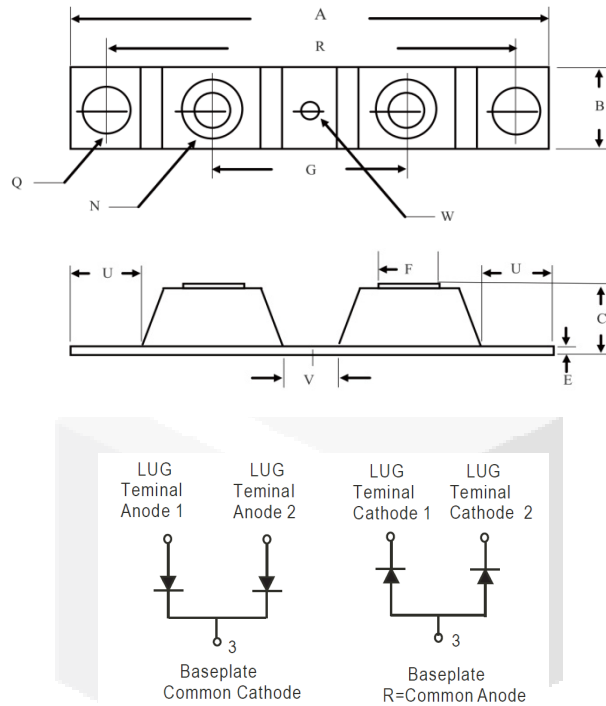


Figure .4- Typical Reverse Characteristics



Package dimensions and terminal configuration

Product is marked with part number and terminal configuration.



DIM	Inches		Millimeters	
	Min	Max	Min	Max
A	----	3.630	----	92.40
B	0.700	0.800	17.78	20.32
C	----	0.650	----	16.51
E	0.130	0.141	3.30	3.60
F	0.482	0.490	12.25	12.45
G	1.368	BSC	34.75	BSC
N	1/4-20 UNC FULL			
Q	0.275	0.290	6.99	7.37
R	3.150	BSC	80.01	BSC
U	0.600	----	15.24	----
V	0.312	0.370	7.92	9.40
W	0.180	0.195	4.57	4.95

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[GeneSiC Semiconductor:](#)

[MBR200200CTR](#) [MBR200150CTR](#) [MBR200200CT](#) [MBR200150CT](#)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.